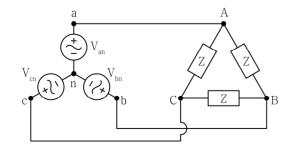
전기이론

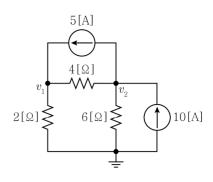
- 문 1. 일반적으로 도체의 전기 저항을 크게 하기 위한 방법으로 옳은 것만을 모두 고르면?
 - ㄱ. 도체의 온도를 높인다.
 - ㄴ. 도체의 길이를 짧게 한다.
 - ㄷ. 도체의 단면적을 작게 한다.
 - ㄹ. 도전율이 큰 금속을 선택한다.
 - ① 7. ⊏
 - ② ¬, ≥
 - ③ ∟, ⊏
 - ④ ⊏, ⊒
- 문 2. 평등 자기장 내에 놓여 있는 직선의 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 도선의 길이에 반비례한다.
 - ② 자기장의 세기에 비례한다.
 - ③ 도선에 흐르는 전류의 크기에 반비례한다.
 - ④ 자기장 방향과 도선 방향이 평행할수록 큰 힘이 발생한다.
- 문 3. 환상 솔레노이드의 평균 둘레 길이가 50 [cm], 단면적이 1 [cm²], 비 투자율 $\mu_r = 1{,}000$ 이다. 권선수가 200회인 코일에 1 [A]의 전류를 흘렸을 때, 환상 솔레노이드 내부의 자계 세기[AT/m]는?
 - ① 40
 - 2 200
 - ③ 400
 - 4 800
- 문 4. 그림과 같은 평형 3상 회로에서 $V_{an} = V_{bn} = V_{cn} = \frac{200}{\sqrt{3}}$ [V],

 $Z = 40 + j30[\Omega]$ 일 때, 이 회로에 흐르는 선전류[A]의 크기는? (단, 모든 전압과 전류는 실횻값이다)



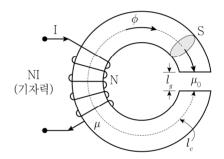
- ① $4\sqrt{3}$
- ② $5\sqrt{3}$
- $3 6\sqrt{3}$
- $4 7\sqrt{3}$

문 5. 그림의 회로에서 전압 v_2 [V]는?



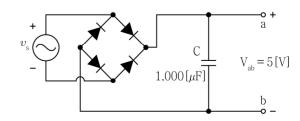
- ① 0
- ② 13
- ③ 20
- 4) 26

문 6. 그림과 같이 미세공극 l_g 가 존재하는 철심회로의 합성자기저항은 철심부분 자기저항의 몇 배인가?



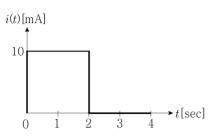
- $2 1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l_c}$
- (4) $1 + \frac{\mu l_c}{\mu_0 l_g}$

문 7. 그림의 직류 전원공급 장치 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이고, 커패시터의 초기 전압은 0[V]이다)



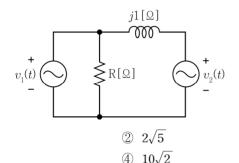
- ① 일반적으로 서지전류가 발생한다.
- ② 다이오드를 4개 사용한 전파 정류회로이다.
- ③ 콘덴서에는 정상상태에서 12.5[mJ]의 에너지가 축적된다.
- ④ C와 같은 용량의 콘덴서를 직렬로 연결하면 더 좋은 직류를 얻을 수 있다.

문 8. $2[\mu F]$ 커패시터에 그림과 같은 전류 i(t)를 인가하였을 때. 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 커패시터에 저장된 초기 에너지는 없다)

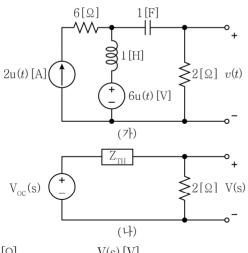


- ① t = 1에서 커패시터에 저장된 에너지는 25[J]이다.
- ② t > 2 구간에서 커패시터의 전압은 일정하게 유지된다.
- ③ 0 < t < 2 구간에서 커패시터의 전압은 일정하게 증가한다.
- ④ t = 2에서 커패시터에 저장된 에너지는 t = 1에서 저장된 에너지의 2배이다.

문 9. 그림의 교류회로에서 저항 R에서의 소비하는 유효전력이 10[W]로 측정되었다고 할 때, 교류전원 $v_1(t)$ 이 공급한 피상전력[VA]은? (단, $v_1(t) = 10\sqrt{2}\sin(377t)$ [V], $v_2(t) = 9\sqrt{2}\sin(377t)$ [V]이다)



문 10. 그림의 (가)회로를 (나)회로와 같이 테브난(Thevenin) 등가변환 하였을 때, 등가 임피던스 $Z_{TH}[\Omega]$ 와 출력전압 V(s)[V]는? (단, 커패시터와 인덕터의 초기 조건은 0이다)



 $Z_{\text{TH}}[\Omega]$

① $\sqrt{10}$

③ 10

V(s)[V]

4(s+3) $(s+1)^2$

$$2 \frac{s^2+1}{s}$$

4(s+3) $(s+1)^2$

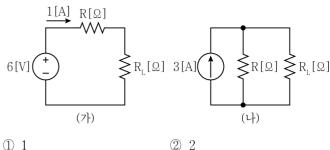
$$3 \frac{s}{s^2+1}$$

 $4(s^2+1)(s+3)$ $s(2s^2+s+2)$

$$\frac{s^2+1}{}$$

 $4(s^2+1)(s+3)$ $s(2s^2+s+2)$

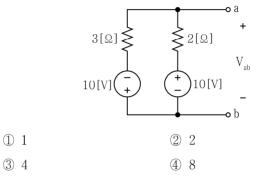
문 11. 그림의 (가)회로와 (나)회로가 등가관계에 있을 때. 부하저항 $R_L[\Omega]은?$



③ 3

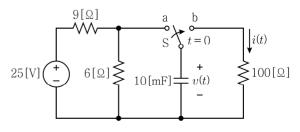
4

문 12. 그림의 회로에서 전압 Vab [V]는?



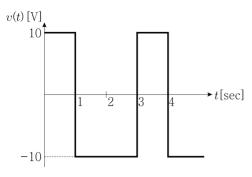
- 문 13. R-L 직렬회로에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 주파수가 증가하면 전류는 증가하고, 저항에 걸리는 전압은 증가한다.
 - ② 주파수가 감소하면 전류는 증가하고, 저항에 걸리는 전압은 감소한다.
 - ③ 주파수가 증가하면 전류는 감소하고, 인덕터에 걸리는 전압은 증가한다.
 - ④ 주파수가 감소하면 전류는 감소하고, 인덕터에 걸리는 전압은 감소한다.

문 14. 그림의 회로에서 스위치 S가 충분히 긴 시간 동안 접점 a에 연결되어 있다가 t = 0에서 접점 b로 이동하였다. 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

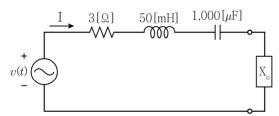


- ① v(0) = 10 [V]이다.
- ② t > 0에서 $i(t) = 10e^{-t}$ [A]이다.
- ③ t > 0에서 회로의 시정수는 1[sec]이다.
- ④ 회로의 시정수는 커패시터에 비례한다.

문 15. 그림과 같이 주기적으로 변하는 전압 v(t)의 실횻값[V]은?



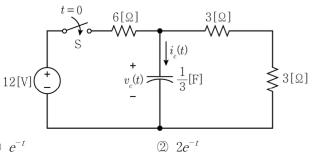
- 4 10
- 문 16. R-L-C 직렬공진회로, 병렬공진회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 직렬공진, 병렬공진 시 역률은 모두 1이다.
 - ② 병렬공진회로일 경우 임피던스는 최소, 전류는 최대가 된다.
 - ③ 직렬공진회로의 공진주파수에서 L과 C에 걸리는 전압의 합은
 - ④ 직렬공진 시 선택도 Q는 $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ 이고, 병렬공진 시 선택도 Q는 $R\sqrt{\frac{C}{I}}$ 이다.
- 문 17. 그림의 회로에서 전류 I[A]의 크기가 최대가 되기 위한 X_0 에 대한 소자의 종류와 크기는? (단, $v(t) = 100\sqrt{2}\sin 100t$ [V]이다)



소자의 종류

소자의 크기

- 인덕터 (1)
- 50 [mH]
- (2) 인덕터
- 100 [mH]
- 커패시터 (3)
- $1,000 [\mu F]$
- 커패시터 (4)
- $2,000 [\mu F]$
- 문 18. 그림의 회로에서 스위치 S를 t=0에서 닫았을 때, 전류 $i_{s}(t)$ [A]는? (단, 커패시터의 초기 전압은 0[V]이다)

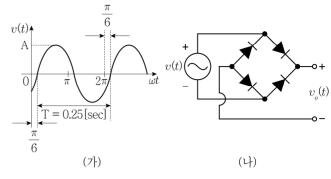


 $\bigcirc e^{-t}$

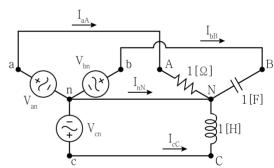
③ e^{-2t}

ⓐ $2e^{-2t}$

문 19. 그림 (가)의 입력전압이 (나)의 정류회로에 인가될 때. 입력전압 v(t)와 출력전압 $v_o(t)$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 다이오드는 이상적인 소자이고, 출력전압의 평균값은 200 [V]이다)



- ① 입력전압의 주파수는 4[Hz]이다.
- ② 출력전압의 최댓값은 100π [V]이다.
- ③ 출력전압의 실횻값은 $100\pi\sqrt{2}$ [V]이다.
- ④ 입력전압 $v(t) = A\sin(\omega t 30^\circ)$ [V]이다.
- 문 20. 그림의 Y-Y 결선 불평형 3상 부하 조건에서 중성점 간 전류 $I_{\mathrm{nN}}\left[\mathrm{A}\right]$ 의 크기는? (단, $\omega=1\left[\mathrm{rad/s}\right],\ V_{\mathrm{an}}=100\,\angle\,0\,^{\circ}\left[\mathrm{V}\right],$ $V_{bn} = 100 \angle -120\,^{\circ}$ [V], $V_{cn} = 100 \angle -240\,^{\circ}$ [V]이고, 모든 전압과 전류는 실횻값이다)



- ① $100\sqrt{3}$
- ② $200\sqrt{3}$
- $3 100 + 50\sqrt{3}$
- (4) $100 + 100\sqrt{3}$